PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-269791

(43)Date of publication of application: 25.09.1992

(51)Int.CI.

G09G 3/36

G02F 1/133

(21)Application number: 03-050237

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

25.02.1991

(72)Inventor: TAKAHATA MASARU

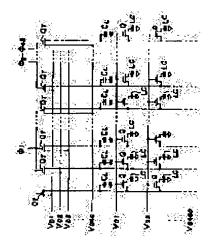
KITAJIMA MASAAKI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the liquid crystal display device which has superior display quality and reduced in cost by decreasing the number of signal-side drivers without decreasing the number of picture elements.

CONSTITUTION: For example, optional gate voltage terminals among terminals VG1-VG480 as scanning-side lead-out electrodes are selected and one scanning line is selected. While this one scanning line is selected, a select signal is supplied to select signal terminals ϕ1ϕ48 in order and while one select signal terminal ϕ1 is selected, a display signal for 40 columns is supplied to display signal terminals VD1-VD40 and written in a capacitor CL; and further respective liquid crystal parts LC are driven through driving TFTQs. After this operation is performed 48 times, display data are written in all the liquid crystal parts LC as a one-line display part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-269791

(43)公開日 平成4年(1992)9月25日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 9 G			7926-5G		
G 0 2 F	1/133	5 5 0	7820-2K		

審査請求 未請求 請求項の数9(全 9 頁)

(21)出願番号	特願平3-50237	(71)出願人	000005108	
			株式会社日立製作所	
(22)出顧日	平成3年(1991)2月25日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地	
		(72)発明者	高島の勝	
			茨城県日立市久慈町4026番地株式会社日立	
			製作所日立研究所内	
		(72)発明者	北島 雅明	
		,	茨城県日立市久慈町4026番地株式会社日立	
			製作所日立研究所内	
		(74)代理人	弁理士 武 顕次郎	

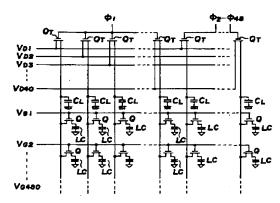
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【目的】 画素数を減少させることなく信号側ドライバの数を減少させて低コストとすることができ、かつ、表示品質の優れた液晶表示装置を提供する。

【構成】 いま、走査側の引出し電極であるゲート電圧 端子 $V_{\text{C1}} \sim V_{\text{C480}}$ の任意のものが選択され、1本の走査 ラインが選択されているものとする。この1本の走査ラインが選択されている間、選択信号端子 $\phi_1 \sim \phi_{\text{4.8}}$ に順次選択信号が与えられ、1つの選択信号端子 ϕ_1 が選択されている間に、40列分の表示信号が表示信号端子 $V_{\text{D1}} \sim V_{\text{D40}}$ に与えられ、コンデンサ C_{L} に書き込まれた後、さらに、駆動用のTFTQを介して各液晶LCが駆動される。そして、この動作が48回にわたって行われたとき、1ライン分の表示部である液晶LCの全てに表示データが書き込まれる。

[2] /].



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の走査電極と複数の表示信号電極との交点のそれぞれに画素駆動用のTFTと画素となる液晶とを備えて構成されるアクティブマトリクス液晶表示装置において、前記複数の表示信号電極は、各列毎にトランスファーゲートTFTとラインメモリとなるコンデンサとを備え、前記表示信号電極を複数の群に分割し、1走査電極が選択されている間に、分割された表示信号電極の各群を順番に選択し、1つの表示信号電極群が選択されている間に、その群の各表示信号電極に対する画 10 像信号を、前記トランスファゲートTFTを介して前記ラインメモリとなるコンデンサ書き込み、さらに、前記画案駆動用のTFTを介して画素に画像信号を書き込むことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 行列方向に配置された各画素と対応する ように設けられた画素駆動用TFT、該TFTのゲート 電極を各行毎に共通接続する走査電極、前記TFTのソ ース/ドレインの一方を各列毎に共通に接続する表示信 号電極、前記走査電極に対する駆動信号出力を制御する 走査側駆動回路、及び、前記表示信号電極に対する駆動 信号出力を制御する表示信号側駆動回路を備えて構成さ れる液晶表示装置において、前記表示信号電極は、各列 毎にトランスファーゲートTFTとラインメモリとなる コンデンサとを備え、前記複数の表示信号電極が複数の 群に分割され、分割された各群に共通な表示信号電極群 はそれぞれ複数のトランスファーゲートTFTのソース **/ドレインの一方に接続され、前記分割された表示信号** 電極の各群を選択する選択信号電極群はそれぞれ複数の トランスファゲートTFTのゲートに接続されているこ とを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 前記表示信号電極は2群に分割され、前記分割された各群に共通な表示信号電極群はそれぞれ2個のトランスファゲートTFTのソース/ドレインの一方に接続され、2個の選択信号電極はそれぞれ複数のトランスファーゲートTFTのゲートに接続されていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記表示信号電極は奇数列(或は偶数列)毎にトランスファーゲートTFTとラインメモリとなるコンデンサとを備え、前記分割された各群に共通な表示信号電極群はそれぞれ奇数列(或は偶数列)のトランスファーゲートTFTのソース/ドレインの一方及び隣接する偶数列(或は奇数列)の信号電極に接続され、1つの選択信号電極はトランスファーゲートTFTのゲートに接続されていることを特徴とする請求項2記載の

【請求項5】前記表示信号電極は、K(Kは2以上)列 毎以外の全ての列にトランスファーゲートTFTとライ ンメモリとなるコンデンサとを備え、前記分割された各 群に共通な表示信号電極群はそれぞれ複数のトランスフ

液晶表示装置。

信号電極に直接接続され、前記分割された表示信号電極の各群を選択する選択信号電極群はそれぞれ複数のトランスファゲート下下のゲートに接続されていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項6】 アクティブマトリクス液晶ディスプレイの1 画素の構成において、表示信号電極は画素駆動用のTFTのソース/ドレインの一方に接続され、前記TFTのソース/ドレインの他方は液晶の一方の端子部に接続され、液晶の他方の端子部には共通電位が与えられ、前記TFTのゲートは各画素毎に設けられるトランスファーゲートTFTのソース/ドレインの一方及びストレージ容量の一方の電極と接続され、ストレージ容量の他方の電極は接地され、トランスファーゲートTFTのソース/ドレインの他方にはゲート電圧が印加され、トランスファーゲートTFTのゲートには選択信号が印加されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】 アクティブマトリクス液晶ディスプレイの1 画素の構成において、表示信号電極は画素駆動用のTFTのソース/ドレインの一方に接続され、前記TF20 Tのソース/ドレインの他方は液晶の一方の端子部に接続され、液晶の他方の端子部には共通電位が与えられ、前記TFTのゲートは各画素毎に設けられるトランスファーゲートTFTのソース/ドレインの一方と接続され、トランスファーゲートTFTのソース/ドレインの他方にはゲート電圧が印加され、トランスファーゲートTFTのゲートには選択信号が印加されることを特徴とする液晶表示装置。

[請求項8] 請求項6または7記載の1画素の構成を 備えるアクティブマトリクス液晶ディスプレイにおい て、表示信号電極群はそれぞれ複数の表示信号電極に接 続され、選択信号電極群はそれぞれ複数列のトランスファゲートTFTのゲートに接続されることを特徴とする 液晶表示装置。

【請求項9】 前記TFTは多結晶シリコンTFTであることを特徴とする請求項1ないし8のうち1記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置に係り、特 40 に、TFT (ThinFilm Transistor) 基板に構成され たアクティブマトリクス液晶ディスプレイを用いた液晶 表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】アクティブマトリクス液晶ディスプレイ の構成に関する従来技術として、例えば、ジャパン・ディスプレイ 89(1989年)第510頁~第513頁(Japan Display '89(1989)、pp. 510-513)等に記載された技術が知られている。

群に共通な表示信号電極群はそれぞれ複数のトランスフ 【0003】図9は従来技術によるアクティブマトリク ァーゲートTFTのソース/ドレインの一方及び1本の 50 ス液晶ディスプレイ装置の構成を示す概略図である。図

9 において、LCは液晶、Qは画素駆動用TFT、 V. p1~Vp1920は表示信号端子、Vc1~Vc480はゲート電 圧端子である。

【0004】図示従来技術は、640×480のカラー 画素を有する液晶表示装置の例であり、走査側に480 本の引出し電極であるゲート電圧端子 Vc1~Vc480、表 示信号側に1920本の引出し電極である表示信号端子 V_{D1}~V_{D1920}、を備え、これらの引き出し電極の交点 に画素駆動用のTFTQを介して画素となる液晶LCが 接続されて構成されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】前記従来技術は、表示 信号側に1920本もの引き出し電極を必要とするた め、信号側ドライバも同数だけ必要となり、信号側ドラ イバのコストが増大するという問題点を有している。

【0006】本発明の目的は、前記従来技術の問題点を 解決し、画素数を減少させることなく信号側ドライバの 数を減少させることによりコストを低下させることがで き、かつ、表示品質の優れた液晶表示装置を提供するこ とにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明によれば前記目的 は、信号側駆動回路の各列毎にトランスファーゲートT FTと、ラインメモリとなるコンデンサとを備え、信号 側としての表示信号端子をm個づつのn個の群に分割 し、表示信号端子V_{D1}~V_{D0}のそれぞれを複数のトラン スファゲートTFTのソース/ドレインの一方に接続 し、選択信号端子φ1~φ のそれぞれを複数のトランス ファーゲートTFTのゲートに接続して、信号側を構成 することにより達成される。

[0008]

【作用】任意の走査ラインが選択されている間、選択信 号端子φ1~φ.からの選択信号により順次m列分の信号 側駆動回路がn回にわたって選択され、走査ライン上の m×n個の液晶のそれぞれに表示信号が書き込まれる。

【0009】従って、本発明によれば、m本の表示信号 端子V₀₁~V₀2と、n本の選択信号端子φ1~φ2とによ り、m×n個の液晶のそれぞれに独立の表示信号を書き 込むことができ、これにより、信号側ドライバの数をm +n個とすることができるのでコストの低減を図ること 40 ができる。

[0010]

【実施例】以下、本発明による液晶表示装置の実施例を 図面により詳細に説明する。

【0011】図1は本発明の第1の実施例の構成を示す 図である。図1に示す本発明の第1の実施例は、多結晶 シリコンを用いたアクティブマトリクス液晶ディスプレ イの例であり、1920本の信号側である表示信号端子 を48群に分割した例である。同図において、Qtはト ランスファーゲートTFT、 C_1 はラインメモリとなる 50 $_1$ 、 $φ_2$ の 2個のみとし、表示信号端子を端子 $V_{11} \sim V$

コンデンサであり、他の符号は図9の場合と同一であ る。

【0012】図1に示す本発明の第1の実施例におい て、表示信号側駆動回路となる表示信号電極は、各列毎 にトランスファーゲートTFTQrと、ラインメモリと なるコンデンサCLとを備え、表示信号端子VD1~VD40 は、それぞれ複数のトランスファーゲートTFTQIの ソース/ドレインの一方に接続され、選択信号端子φ1 ~ φ48は、それぞれ複数のTFTQIのゲートに接続さ 10 れている。

【0013】前述のように構成される本発明の第1の実 施例は、次のように動作する。

【0014】いま、走査側の引出し電極であるゲート電 圧端子 V に1~ V に110 の任意のものが選択され、1本の走 査ラインが選択されているものとする。

【0015】この1本の走査ラインが選択されている 間、選択信号端子 φ1 ~ φ11 に順次選択信号が与えら れ、1つの選択信号端子 ϕ $_1$ が選択されている間に、40列分の表示信号が表示信号端子V_{D1}~V_{D40}に与えら れ、めもりとなるコンデンサCiに書き込まれ、さら に、駆動用のTFTQを介して各液晶LCが駆動され る。そして、この動作が48回にわたって行われたと き、1ライン分の表示部である液晶LCの全てに表示デ ータが書き込まれたことになる。

【0016】すなわち、図示実施例は、1本の走査ライ ンが選択されている時間、例えば、時間丁の間に、選択 信号端子φ1~φ48に、端子φ1から順にT/48時間の 選択信号が与えられ、この選択信号端子 φ1~ φ48 に与 えられる選択信号に同期して、表示信号端子Ⅴ□1~Ⅴ раоには、1920の表示信号が、40個分を1群とし て順次与えられて、表示の制御が行われている。

【0017】前述した本発明の第1の実施例によれば、 従来、信号側に1920本の引出し電極が必要であり、 1920個のドライバが必要であったものが、88(4 0+48)本の引出し電極と、これらの引き出し電極に 対応する88個のドライバにより液晶表示装置の信号側 を構成することができ、これにより、信号側ドライバの コストを低減することができる。

【0018】図2は本発明の第2実施例の構成を示す図 であり、図2(a)はその構成を示す図、図2(b)は 動作を説明するタイミングチャートである。この本発明 の第2の実施例は、非晶質シリコンを用いたアクティブ マトリクス液晶ディスプレイの実施例であり、図2 (a) における符号は図1の場合と同一である。

【0019】図2(a)に示す本発明の第2の実施例の 構成において、信号側駆動回路の一部であるトランスフ ァーゲートTFTQtは、レーザアニール等の熱処理に よって多結晶化された多結晶シリコンTFTにより構成 されている。また、この例では、選択信号端子を端子の

ppsp の960個としている。この理由は、非晶質シリコ ンによる駆動用のTFTQのオン抵抗が高いため、ライ ンメモリとなるコンデンサCLから液晶LCへの充電に 多結晶シリコンによるTFTの場合より多くの時間を要 するためである。

【0020】この本発明の第2の実施例は、前述の第1 の実施例の場合と同様に、信号側駆動回路が各列毎に、 トランスファーゲートTFTQrと、ラインメモリとな るコンデンサCLとを備え、表示信号端子Vp1~Vp980 方のソース/ドレインに接続され、選択信号端子群 φ1、φ2が、それぞれ複数のTFTQTのゲートに接続 されて構成されている。

【0021】この実施例は、図2(b)に示すように、 任意の走査ラインが選択されている間に、1920列分 の表示信号が、960列分づつに分けられて2回にわた って、ラインメモリとなるコンデンサCi、駆動用のT FTQを介して表示部の液晶LCに書き込まれることに より表示の制御が行われる。

【0022】前述の本発明の第2の実施例によれば、従 20 来技術の場合の1920本の引出し電極と1920個の ドライバとによる信号側を、962 (960+2) 本の 引出し電極と962個のドライバとにより構成すること が可能となる。

【0023】図3は本発明の第3の実施例を説明する図 であり、図3(a)はその構成を示す図、図3(b)は 動作を説明するタイミングチャートである。この本発明 の第3の実施例は、非晶質シリコンを用いたアクティブ マトリクス液晶ディスプレイの例であり、図3(a)に おける図の符号は図1の場合と同一である。

【0024】図3(a)に示す本発明の第3の実施例の 構成において、信号側駆動回路の一部であるトランスフ ァーゲートTFTQtは、レーザアニール等の熱処理に よって多結晶化された多結晶シリコンTFTにより構成 されている。

【0025】図3(a)に示す本発明の第3の実施例 は、信号側駆動回路の奇数列毎にトランスファーゲート TFTQtとラインメモリとなるコンデンサCLを備え、 表示信号端子Vp1~Vp980が、それぞれ奇数列のトラン スファーゲートTFTQ:の一方のソース/ドレイン及 40 ることを可能とした本発明の実施例について説明する。 び隣接する偶数列の信号電極に接続され、選択信号φが トランスファーゲートTFTQrのゲートに接続されて 構成されている。

【0026】この本発明の第3の実施例の動作を、走査 側の引き出し電極であるゲート電圧端子Vc1にオン電圧 が印加されているものとして、図3(b)に示すタイミン グチャートにより説明する。

【0027】まず、端子Vc1にオン電圧が印加されてい る期間に、表示信号端子Vp1~Vp960に1行目の走査ラ インに対する奇数列のデータを設定し、選択信号φをオ *50* 方に接続され、TFTQ1のソース/ドレインの他方が

ン電圧にする。これにより、オン状態の駆動用TFTQ 1を経由して1列目と2列目の液晶端子部には端子 V11 の印加電圧が、3列目と4列目の液晶端子部には端子V 12の印加電圧が、……1919列目と1920列目の液 晶端子部には端子Ⅴ₃ҫ₀の印加電圧がそれぞれ印加さ れ、これにより各液晶LCに書き込みが行われる。その 後、選択信号φをオフ電圧とし、端子Vp1~Vp960を1 行目の走査ラインに対する偶数列のデータに設定する と、トランスファゲートTFTQrがオフ状態となるの が、それぞれ 2 個のトランスファゲートTFTQr の-10 で、今度は、2 列目の液晶端子部には端子 V_{P1} の印加電 圧が、4列目の液晶端子部には端子V₁₂の印加電圧が、 ……1920列目の液晶端子部には端子V₁₉₆₀の印加電 圧がそれぞれ印加され、偶数列の各液晶LCに対する書 き込みが行われる。

> 【0028】すなわち、本発明の第3の実施例は、最初 に、奇数列の表示信号を隣合う2つの液晶LCに書き込 み、その後、偶数列の液晶しCを、本来の偶数列の表示 信号に書き替えるように制御することにより、1走査ラ イン上の表示信号の書き込みを行うものである。

【0029】このような本発明の第3の実施例は、前述 した本発明の第2実施例に比較して、トランスファゲー トTFTQI、及び、記憶素子としてのコンデンサCLの 数を、それぞれ1/2にすることができ、これにより、 製造歩留りの向上を図ることができる。

【0030】また、この本発明の第3の実施例によれ ば、従来技術の場合の1920本の引出し電極と192 0個のドライバとによる信号側を、961 (960+ 1) 本の引出し電極と961個のドライバとにより構成 することが可能となる。

【0031】ところで、通常、液晶表示装置において は、走査電極と信号電極との交点に重なり抵抗Rcross が生じるが、前述した実施例では、製造プロセスのばら つき等によって前記重なり抵抗Rcrossの値が比較的低 くなる場合がある。このような場合、トランスファゲー トTFTQtがオフ状態時に、メモリとしてのコンデン サCL に蓄積された電荷が抵抗 R crossを経由して放電さ れてしまい、アクティブマトリクス液晶ディスプレイの 表示品質を劣化させてしまう。

【0032】そこで、以下では前述した問題点を解決す

【0033】図4は本発明の第4実施例を説明する図で あり、図4(a)は表示部1画素の構成を示す図、図4 (b)はその動作タイミングチヤートである。この本発明 の第4の実施例は、トランスファゲートTFTを各画素 に備えるようにした実施例であり、図4(a)において、 Q1、Q2は多結晶シリコンTFT、Cs16はストレージ 容量であり、他の符号は図3の場合と同一である。

【0034】図示本発明の第4の実施例は、表示信号端 子V_Dが画素駆動用のTFTQ₁のソース/ドレインの一 7

液晶LCの一方の端子に接続され、液晶LCの他方の端子に共通電位Vcomが与えられ、TFTQ1のゲートがトランスファゲートTFTQ2のソース/ドレインの一方及びストレージ容量Cs1cの一方の電極と接続され、ストレージ容量Cs1cの他方の電極が接地され、TFTQ2のソース/ドレインの他方にゲート電圧端子Vcが接続され、TFTQ2のゲートに選択信号端子φが接続されて構成されている。

【0035】その動作は、図4(b)に示すタイミングチャートに従って次のように行われる。

- 1) ゲート電圧端子 V_c にオン電圧が印加されている期間に、選択信号端子 ϕ にオン電圧を印加すると、 $TFTQ_1$ 、 Q_2 はオン状態になり、表示信号端子 V_a に与えられている表示信号は、 $TFTQ_1$ を経由して液晶しCの端子に直ちに与えられ、液晶しCに書き込まれる。
- 2) 次に、ゲート電圧端子 V_0 をオフ電圧にすると、TFT Q_2 がオン状態、TFT Q_1 がオフ状態となる。
- 3) その後、選択信号端子 ϕ をオフ電圧にすると、TF TQ_1 、 Q_2 がオフ状態に保たれる。
- 4) 以下、前述した1)~3)の動作を繰り返す。

【0036】本発明の第4の実施例は、前述したように駆動制御されるが、このような駆動方法によれば、表示信号端子 V_0 からの表示信号は、オン状態のTFT Q_1 を経由して液晶LCの端子部に印加されて書き込まれる。その後、TFT Q_1 は直ちにオフ状態に制御されることになるので、液晶LCに書き込まれた表示信号は、走査電極と信号電極との重なり抵抗Rcrossによって保持されることなく、TFT Q_1 のオフ抵抗により保持されることになる。

【0037】一般に、TFTのオフ抵抗はRcrossに比べて桁違いに高いため、前述した本発明の第4の実施例によれば、走査電極と信号電極との重なり抵抗Rcrossが比較的低い場合にも、アクティブマトリクス液晶ディスプレイの表示品質の劣化を防止することができる。

【0038】図5は本発明の第5の実施例を説明する図であり、図5(a)は表示部1画素の構成を示す図、図5(b)は動作を説明するタイミングチヤートである。この本発明の第5の実施例は、前述の本発明の第4の実施例の場合と同様に、各画素毎にトランスファゲートTFTを設けたものである。図5(a)における図の符号は図4 40の場合と同一である。

【0039】図示本発明の第5の実施例は、表示信号端子V。が画素駆動用のTFTQ1のソース/ドレインの一方に接続され、TFTQ1のソース/ドレインの他方が被晶LCの一方の端子部に接続され、液晶LCの他方の端子部に共通電位Vcomが与えられ、TFTQ1のゲートがトランスファゲートTFTQ2のソース/ドレインの一方と接続され、TFTQ2のゲートに選択信号端子もが接続されて構成されている。

【0040】その動作は、図4(b)に示すタイミングチャートに従って次のように行われる。

- 1) ゲート電圧端子 $V_{\mathfrak{a}}$ にオン電圧が印加されている期間に、選択信号端子 ϕ にオン電圧を印加すると、TFT $Q_{\mathfrak{1}}$ 、 $Q_{\mathfrak{2}}$ はオン状態になり、表示信号端子 $V_{\mathfrak{3}}$ に与えられている表示信号は、 $TFTQ_{\mathfrak{1}}$ を経由して液晶LCの端子に直ちに与えられ、液晶LCに書き込まれる。
- 2) 次に、ゲート電圧端子V₆をオフ電圧にすると、T FTQ₂がオン状態、TFTQ₁がオフ状態となる。
- 10 3) その後、選択信号端子φをオフ電圧にすると、TF TQ1、Q2がオフ状態に保たれる。
 - 4) 以下、前述した1)~3)の動作を繰り返す。

【0041】本発明の第5の実施例は、前述したように 駆動制御されるが、このような駆動方法によれば、表示 信号端子Vnからの表示信号は、オン状態のTFTQ1を 経由して液晶LCの端子部に印加されて書き込まれる。 その後、TFTQ1は直ちにオフ状態に制御されことに なるので、液晶LCに書き込まれた表示信号は、走査電 極と信号電極との重なり抵抗Rcrossによって保持され ることなく、TFTQ1のオフ抵抗により保持されることになる。

【0042】一般に、TFTのオフ抵抗はRcrossに比べて桁違いに高いため、前述した本発明の第5の実施例によれば、走査電極と信号電極との重なり抵抗Rcrossが比較的低い場合にも、アクティブマトリクス液晶ディスプレイの表示品質の劣化を防止することができる。

電極と信号電極との重なり抵抗Rcrossによって保持さ $(0043) \otimes 6$ は本発明の第6 実施例の構成を示すれることなく、 $(0043) \otimes 7$ になる。 $(0037) \otimes 7$ になる。 $(0037) \otimes 7$ にあいため、前述した本発明の第4 の実施例 $(0037) \otimes 7$ に適いため、前述した本発明の第 $(0037) \otimes 7$ に適いため、前述した本発明の第 $(0037) \otimes 7$ に適用した場合の例である。

【0044】図6に示す本発明の第6の実施例は、表示信号端子 V_{D40} が、それぞれ、複数の信号電極に接続され、選択信号端子 $\phi_1 \sim \phi_{48}$ が、それぞれ、複数列のTFT Q_{21} (Kは $1\sim48$)のゲートに接続されて構成されている。

【0045】このように構成される本発明の第6の実施例の動作を、走査側の引き出し電極であるゲート電圧端子Vo1にオン電圧が印加されているものとして、図7に示すタイミングチャートにより説明する。

【0046】1)ゲート電圧端子 V_{c1} に1回目のオン電圧が印加されている期間に、選択信号端子 ϕ_1 をオン電圧にすると、選択信号端子 ϕ_1 がそのゲートに接続されているトランスファゲートTFT Q_{21} がオン状態になり、その結果、TFT Q_{21} のソース/ドレインの一方がゲートに接続されている画素駆動用TFT Q_{111} もオン状態になる。これにより、表示信号端子 $V_{01}\sim V_{040}$ に与えられている表示信号は、TFT Q_{111} を経由して液晶しての端子部に印加され、液晶しCに書き込まれる。

50 2) 次に、ゲート電圧端子Vc1をオフ電圧にすると、T

Q

FTQ11はオン状態、Q111はオフ状態にされる。

- 3) その後、選択信号端子 ø1 をオフ電圧にすると、T FTQ21、Q111がオフ状態に保たれる。
- 4) さらにその後、ゲート電圧端子V:1に2回目のオン 電圧が印加されている期間に、選択信号端子 02をオン 電圧にすると、この選択信号端子 Φ2 がゲートに接続さ れているTFTQ22はオン状態になり、その結果、TF TQ22のソース/ドレインの一方がゲートに接続されて いるTFTQ112もオン状態になる。従って、表示信号 して液晶LCの端子に与えられ、液晶LCに書き込まれ る。
- 5) その後、ゲート電圧端子Vc1をオフ電圧にすると、 TFTQ22はオン状態、Q112はオフ状態とされる。
- 6) その後、選択信号端子 o2 をオフ電圧にすると、T FTQ22、Q112はオフ状態に保たれる。
- 7) 以下、選択信号端子の3~の48に対しても、順次前 述と同様に駆動を行うことにより、640画素の全てに 表示信号の書き込みが行われる。

【0047】本発明の第6の実施例は、前述したように 20 駆動制御されるが、このような駆動方法によれば、表示 信号端子Voからの表示信号は、オン状態のTFTを経 由して液晶LCの端子部に印加されて書き込まれる。そ の後、このTFTは直ちにオフ状態に制御されことにな るので、液晶LCに書き込まれた表示信号は、走査電極 ど信号電極との重なり抵抗Rcrossによって保持される ことなく、TFTのオフ抵抗により保持されることにな る。

【0048】一般に、TFTのオフ抵抗はRcrossに比 べて桁違いに高いため、前述した本発明の第6の実施例 30 によれば、走査電極と信号電極との重なり抵抗Rcross が比較的低い場合にも、アクティブマトリクス液晶ディ スプレイの表示品質の劣化を防止することができる。

【0049】また、前述した本発明の第6の実施例によ れば、従来技術の場合の1920本の引出し電極と19 20個のドライパとによる信号側を、88(40+4 8) 本の引出し電極と88個のドライバとにより構成す ることが可能となり、信号側ドライバのコストの低減を 図ることができる。

【0050】図8は本発明の第7の実施例を説明する図 40 であり、図8(a)はその構成を示す図、図8(b)はその 動作を説明するタイミングチャートである。この本発明 の第7の実施例は、前述した本発明の第1の実施例と第 3の実施例とを組み合わせて構成したアクティブマトリ クス液晶ディスプレイの例である。

【0051】図8(a)において、少なくとも、信号側駆

10

動回路の一部であるトランスファゲートTFTQrは、 レーザーアニール等の熱処理により、多結晶シリコンT FTにより構成されている。

【0052】この本発明の第7の実施例は、信号側駆動 回路に、K(Kは2以上)列毎以外の各列に、トランス ファーゲートTFTとラインメモリとなるコンデンサC ıとを備え、表示信号端子VpiからVpuがそれぞれ複数 のトランスファーゲートTFTQrのソース/ドレイン の一方及び1本の信号電極に直接接続され、選択信号端 端子 $V_{\mathfrak{p}_1}\sim V_{\mathfrak{p}_4}$ oからの表示信号は、 $\mathrm{TFTQ_{112}}$ を経由 10 子 $\phi_1\sim \phi_{\mathfrak{k}-1}$ がそれぞれ複数のトランスファーゲート T FTQtのゲートに接続されて構成されている。

> 【0053】この本発明の第7の実施例は、図8(b)に 示すタイミングチャートに従って動作するが、この動作 は、前述した本発明の第3の実施例の動作から容易に類 推可能であるので、その説明を省略する。

> 【0054】前述のように構成される本発明の第7の実 施例によれば、前述した本発明の第1の実施例に比較し て、トランスファーゲートQr 及びメモリとなるコンデ ンサCiの個数をそれぞれm個少なくすることができる ので、製造歩留りの向上を図ることができる

[0055]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、信 号側の引出し電極数を低減することができるので、信号 側ドライバのコストの低減を図ることが可能となり、こ れにより、アクティブマトリクス方式を採用した液晶表 示装置の低コスト化を達成することができる。

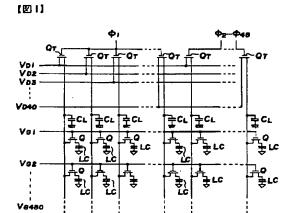
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施例の構成を示す図である。
- 【図2】本発明の第2の実施例を説明する図である。
- 【図3】本発明の第3の実施例を説明する図である。
- 【図4】本発明の第4の実施例を説明する図である。
- 【図5】本発明の第5の実施例を説明する図である。 【図6】本発明の第6の実施例の構成を示す図である。
- 【図7】本発明の第6の実施例の動作を説明するフロー チャートである。
- 【図8】本発明の第7の実施例を説明する図である。
- 【図9】従来技術による液晶表示装置の構成を示す図で ある。

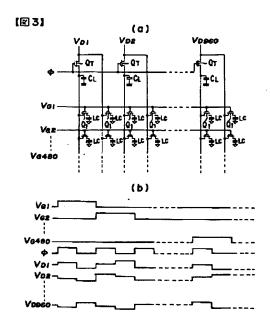
【符号の説明】

- Qr トランスファーゲートTFT
- C₁ ラインメモリ容量
- LC 液晶
- Vc、Vc1~Vc480 ゲート電圧端子
- Vp、Vp1~Vp1920 表示信号端子
- φ、φ1~φ48 選択信号端子

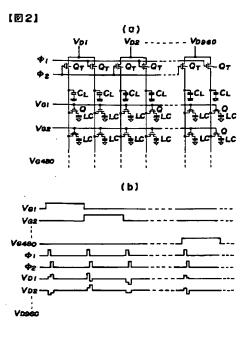
【図1】



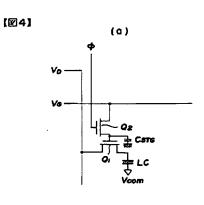
【図3】

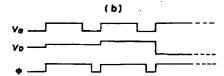


[図2]



【図4】

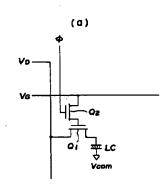




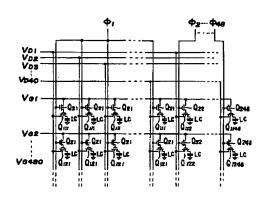
【図5】

【図6】

[**2**5]



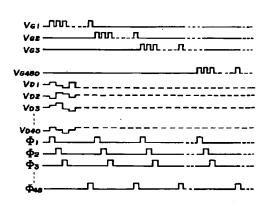
(⊠61

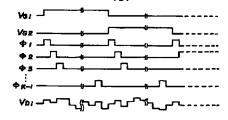


[図8]

【図7】

[图7]





【図9】

[图9]

